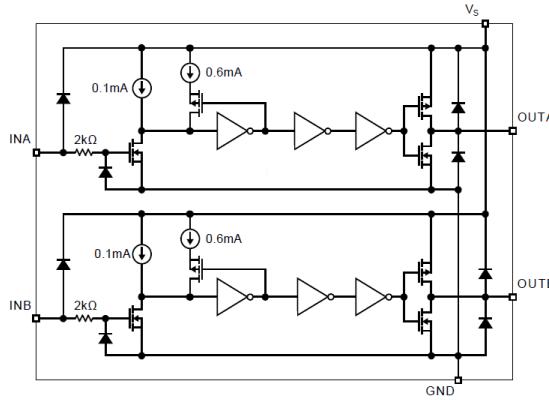




XA-4426双路MOSFET驱动器规格书

主要特点:

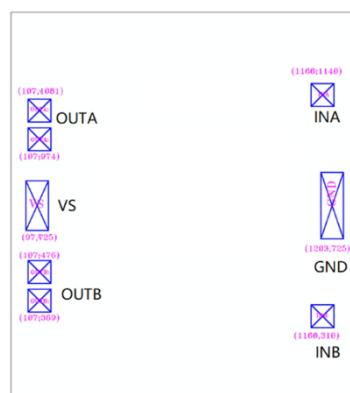
- 高压BICMOS工艺
- 双路1.5A峰值输出电流
- 低静态电流
4mA, 逻辑高输入
0.4mA, 逻辑低输入
- 快速开关时间25ns
- 延迟时间40ns
- 7Ω输出阻抗
- 高可靠性



产品描述:

芯片采用高压、低功耗BICMOS硅工艺制造，包含两路独立的反相驱动器，可将TTL/CMOS信号转换为4.5~18V输出。主要用于驱动功率MOSFET，也可用于驱动电容、电感或电阻等需要低阻抗、大电流、快速开关的应用。可有效替代国外MIC4426/MAX4426等驱动器电路。

芯片尺寸:



	X	Y	单位
芯片尺寸	1350	1500	um
焊盘尺寸/栅极	80	80	um

最大额定值: Ta=25°C



参数	符合	额定值	单位
电源电压	VS	22	V
输入电压	VIN	VS+0.3V~GND-5V	V
结温	Tj	175	°C

主要电特性:

除另有规定外, $4.5V \leq VS \leq 18V$, $T_a = 25^\circ C$

参数		符号	条件	Min	Typ	Max	单位
输入特性	逻辑 1 输入电平	V_{IH}	-	2.4	1.4		V
	逻辑 0 输入电平	V_{IL}	-		1.1	0.8	V
输出特性	输入电流	I_{IN}	$0V \leq V_{IN} \leq V_s$	-1		1	μA
	输出高电平	V_{OH}	-	$V_s - 0.025$			V
开关时间	输出低电平	V_{OL}	-			0.025	V
	输出电阻	R_o	$I_{OUT}=10mA, V_s=18V$		6	10	Ω
电源特性	上升时间	t_R	$C_L=1nF$		23	40	ns
	下降时间	t_F	$C_L=1nF$		27	40	ns
延迟时间	延迟时间	t_{D1}	$C_L=1nF$		26	40	ns
	延迟时间	t_{D2}	$C_L=1nF$		38	60	ns
电源特性	电源电流	I_s	$V_{IN}=3V$ (双输入端)	0.6	1.4	8	mA
			$V_{IN}=0V$ (双输入端)			0.18	

包装要求:

芯片应包装在专用的裸芯片盒里面, 采用防潮、防震和防静电包装。

芯片外包装容器上应注明:

- 芯片型号;
- 检验批识别代码;
- 数量。

贮存要求:

裸芯片应贮存在充有氮气的干燥柜里。

运输要求:

芯片运输过程中应防雨、雪淋袭和机械撞击。